



<b>NAR Labs</b> 國家實驗研究院 <b>台灣半導體研究中心</b>		DOCUMENT NO. : Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (SE-013 光阻去除及濕蝕刻化學槽)		
ISSUE DATE	2019-02-22	REVISION	1.0	PAGE	第 1 / 2 頁

一、目的：

定義光阻去除及濕蝕刻化學槽操作規範，以確保操作品質。

二、範圍：

適用於光阻去除及濕蝕刻化學槽。

三、權責：

1. 組織權責：工程師負責制定及修改規範。
2. 執行人員資格：經過光阻去除及濕蝕刻化學槽考核通過之人員。

四、名詞定義：

無。

五、相關文件：

無。

六、標準作業程序：

1. MES 控制系統開啟設備
2. 填開啟『電源 ON』，再開啟『照明燈』。
3. 點選『主畫面』進入控制模式後再點選『HEPA』。壓力約 10 ~ 15 mm of water
4. 至化學藥品櫃領取所需化學藥品，並填寫記錄本按 ENTER ACCESS CODE 鍵輸入機台密碼。
5. 實驗中，確實穿戴防護器具，口罩→防酸鹼長袍→面罩→耐酸鹼手套。
6. 將蝕刻液倒入結晶皿內，單一製程步驟的最大倒入量蝕刻片數及時間而定。
7. 加熱器上嚴禁放置酒精、異丙醇、丙酮…等有機溶劑或低閃火點的化學溶液。
8. 使用前須先將加熱器鋪上鋁箔紙。
9. 使用加熱器對蝕刻溶液加熱或攪拌。
10. 浸泡結束後以去離子水做沖洗動作。
11. 含 Al 以外之金屬需排放到廢液桶，
12. 發生機台漏液時，請盡速告知工程師，並先拿吸液棉撲在漏液上方。
13. MES 控制系統 關閉設備

<b>NAR Labs</b> 國家實驗研究院 <b>台灣半導體研究中心</b>		DOCUMENT NO. : Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (SE-013 光阻去除及濕蝕刻化學槽)		
ISSUE DATE	2019-02-22	REVISION	1.0	PAGE	第 2 / 2 頁

七、應用表單及附件：

1. Q4-NL02 設備管理卡
2. Q4-NL03 設備考核表
3. Q4-NL04 設備點檢表
4. Q4-NL06 異常及矯正預防處理單